

汎用集積回路

マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラ
(デジタルシグナルプロセッサ、デジタルアレイプロセッサ、
デジタルコプロセッサを含む。)

輸出令別表第1の7の項(1)、省令第6条第一号イ、ロ、ハ

作成責任者：(作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

電話

印

パラメータシート
様式：6-1

CISTEC 2013. 10. 15
(平成25年10月15日施行政省令等対応)

型 名	チェックグループ	1	2	3 (注2)		備 考	判 定 (注5)
	チェック項目	耐放射線設計の有無 (注1)	定格動作温度範囲 (℃) (注1)	主材料名 (注3)	最大クロック周波数 (MHz) (注4)		
	判定基準	(1)全吸収線量($\text{krad}(\text{Si})$) (該) $\geq 5 \times 10^3$ (2)吸収線量率($\text{krad}(\text{Si})/\text{s}$) (該) $\geq 5 \times 10^6$ (3)1MeV相当の中性子束($\text{個}/\text{cm}^2$) (該) $\geq 5 \times 10^{13}$	(1)(該) > 125 (2)(該) < -55 (3)(該) $= -55 \sim 125$	(該) = 化合物 半導体	(該) > 40		
(記載例) ABCxxxxx		—	0~85	Si	—		非該当
(例) PIC16F1937-I/P		—	-40~85	Si	—		非該当
(例) PIC16F1937-E/P		—	-40~125	Si	—		非該当
		耐放射線設計「無」のため「—」	↑データシートの Operating temperature を参照ください。	Si(シリコン)	主材料が化合物半導体 ではないため「—」		
注 積	注1. 耐放射線設計「有」の場合は、全吸収線量、吸収線量率及び中性子束を記入、「無」の場合は欄に「—」を記入する。チェックグループ1の(3)はMIS形のものを除く。チェックグループ1、2は(1)~(3)のいずれかが該当であれば該当。						
	注2. チェックグループ3の該非判定は、チェック項目の双方が該当であれば該当。						
	注3. 主材料名の欄には、具体的材料名を記入(元素記号でも可)。主材料が化合物半導体の場合は、材料名の後に「(化)」と記入すること。						
	注4. 主材料が化合物半導体のとき記入、それ以外の場合には「—」を記入する。						
	注5. チェックグループ1~3のいずれかが該当であれば該当。						